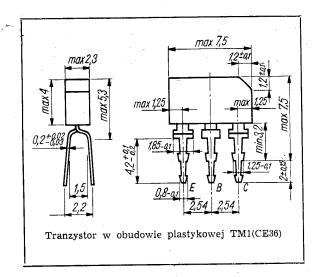
SWW 1156-213

Tranzystor krzemowy epiplanarny małej mocy wielkiej częstotliwości.

Jest przeznaczony do stosowania w stopniach wyjściowych wzmacniaczy pośredniej częstotliwości wizji odbiorników telewizyjnych.



DANE TECHNICZNE

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych

Napięcie kolektor-			
-baza	U_{CB0}	40	v ·
Napięcie kolektor-			
-emiter	U_{CE0}	25	V
Napięcie emiter-baza	U_{EB0}	4	V
Prad kolektora	I_C	25	mA
Prad bazy	I_B	2	mA
Moc całkowita	P_{tot}	250	mW
Temperatura złącza	t_j	398	K
•		(125	°C)
Zakres temperatury			
składowania	t_{stg}	208398	K
		(-65+125	°C)
	•		

Parametry statyczne

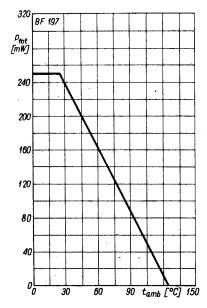
cs.
nA
)

16 Elementy półprzewodnikowe

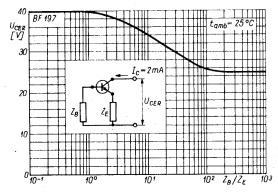
Napięcie przebicia kolektor-baza przy $I_E = 0$,				
$U_{CB} = 10 \mathrm{\mu A}$	$U_{(BR)CB0}$	40		V
Napięcie przebicia	7			
kolektor-emiter				
$przy I_B = 0,$				
$I_{\rm C}=7~{\rm mA}$	$U_{(BR)CE0}$	25		v
Napiecie przebicia			,	
emiter-baza				
$\operatorname{przy} I_C = 0,$	s.			
$I_E = 10 \mu\text{A}$	$U_{(BR)EB0}$	4	_	V
Współczynnik wzmoc-	•			
nienia prądowego				
$przy I_C = 7 mA,$	•	40		
$U_{CE} = 10 \text{ V}$	h_{21E}	40		
$\operatorname{przy} I_{C} = 20 \mathrm{mA},$. 15		
$U_{CE} = 2 \text{ V}$	h_{21E}	15		
Napięcie stałe między bazą a emiterem				
przy $I_C = 7 \text{ mA}$,		•		
$U_{CE} = 10 \text{ V}$	U_{BE}		0,9	v
O CE - 10 A	OBE		0,0	•

Parametry dynamiczne

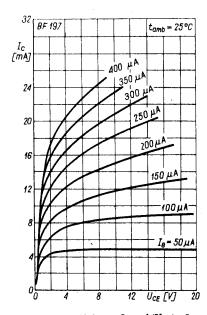
$\operatorname{przy} t_{amb} = 298 \text{ K}$					
(25°C)		min.	typ.	maks.	
Częstotliwość graniczna					
$przy I_C = 7 mA,$					
$U_{CE}=10 \text{ V},$					
f = 100 MHz	f_{2}	350	550	· —	MHz
Pojemność sprzężenia					
zwrotnego					
$przy I_C = 1 mA,$					
$U_{CE} = 10 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	C_{12es}		0,32	0,35	pF
Stała czasowa sprzę-					
żenia zwrotnego					
$przy I_C = 7 mA$,					
$U_{CE} = 10 \text{ V},$			A.		
f = 50 MHz	$r_{bb}'C_C$			10	ps
Konduktancja		,	· ·		
wejściowa			N.		
$przy I_C = 7 mA$,					
$U_{CE} = 10 \text{ V},$		`			
f = 35 MHz	g_{11e}	-	4		mS
Admitancja przeno-					
szenia w przód					
$\operatorname{przy} I_C = 7 \mathrm{mA},$					
$U_{CE} = 10 \text{ V},$					
f = 35 MHz	$ \mathbf{Y}_{21e} $		170	· · · <u>· · ·</u>	mS
Konduktancia	1- 2101				
wyjściowa					
$\operatorname{przy} I_{C} = 7 \mathrm{mA},$					
$U_{CE} = 10 \text{ V},$					
f = 35 MHz	g_{22e}	_	80	_	μS
) - 33 MHZ	9226		~ 0		r



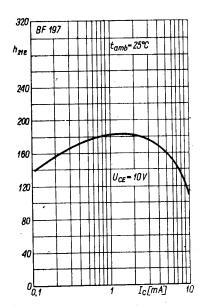
Zależność temperaturowa mocy strat $P_{tot} = f(t_{amb})$



Zależność napięcia kolektor-emiter od stosunku impedancji bazy i emitera $U_{CER}=f\left(\frac{Z_B}{Z_E}\right)$

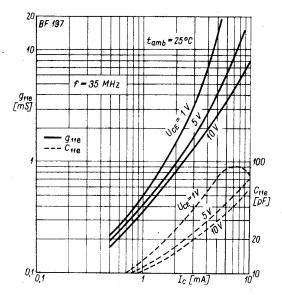


Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE}); I_B$ — parametr

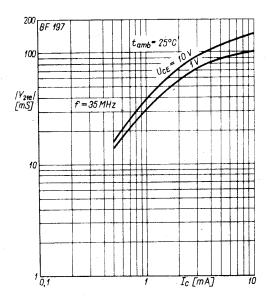


Zależność statycznego współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora $h_{21E}=f\left(I_{C}\right)$

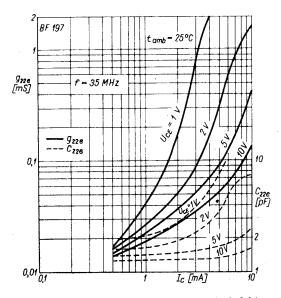
Zależność częstotliwości granicznej od prądu kolektora $f_T=f\left(I_C\right)$



Zależność admitancji wejściowej od prądu kolektora $g_{11e};~C_{11e}=f\left(I_{C}\right)$



Zależność admitancji przejściowej w przód od prądu kolektora $|\mathbf{Y}_{21e}|;\; \varphi_{21e}=f(I_{\mathbf{C}})$



Zależność admitancji wyjściowej od prądu kolektora $g_{22e}; C_{22e} = f(I_C)$